DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 0... Page 1 of 1

PAT-NO:

JP407049428A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 07049428 A

TITLE:

MANUFACTURE OF OPTICAL WAVEGUIDE

PUBN-DATE:

February 21, 1995

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HAKOGI, HIRONAO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

FUJITSU LTDN/A

APPL-NO: JP05193536

APPL-DATE: August 4, 1993

INT-CL (IPC): G02B006/13

ABSTRACT:

PURPOSE: To manufacture a pattern for thermal diffusion without using a resist and a mask by partially heating a metal thin film formed on a base consisting of a ferroelectric body to form an oxidized area, and using the oxidized area as the pattern for thermal diffusion.

CONSTITUTION: A metal thin film consisting of Ti is uniformly formed on a base 12 consisting of LiNbO3, for example, by evaporation. A laser beam is emitted to a determined part of the metal thin film 14 by use of a YAG laser device to heat it, and an oxidized area 16 is formed. The base having the metal thin film 14 and the oxidized area 16 formed thereon is successively dipped in an etching solution for Ti. The non-oxidized part of the metal thin film 14 is removed by etching, but the oxidized area 16 is hardly etched because of its low etching rate, and left as it is to form a pattern. The base having the oxidized area 16 left thereon is heated, for example, at a temperature of 1000°C or more, whereby the oxidized area 16 is thermally diffused in the base 12 to form a high refraction index part 18 on the base 12.

COPYRIGHT: (C) 1995, JPO

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-49428

(43)公開日 平成7年(1995)2月21日

(51) Int.Cl.6

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示箇所

G 0 2 B 6/13

8106-2K

G02B 6/12

M

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 5 頁)

(21)出願番号

特願平5-193536

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

(22)出願日

平成5年(1993)8月4日

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72)発明者 箱木 浩尚

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

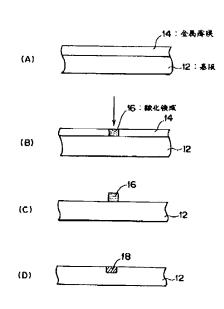
(74)代理人 弁理士 松本 昂

(54) 【発明の名称】 光導波路の製造方法

(57)【要約】

【目的】本発明は光導波路の製造方法に関し、レジスト 及びマスクを使用することなしに熱拡散用のパターンを 容易に作製することができる方法の提供を目的とする。 【構成】強誘電体基板12上に金属薄膜14を形成し、 金属薄膜14を部分的に加熱して酸化領域16を生成 し、酸化領域16を除いて金属薄膜14をエッチングに より除去し、酸化領域16を基板12に熱拡散させる。

第1实施例图



10/21/2004, EAST Version: 1.4.1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 強誘電体からなる基板(12)上に金属薄膜 (14)を形成するステップと、

該金属薄膜(14)を部分的に加熱して酸化領域(16)を生成 するステップと、

該酸化領域(16)を除いて上記金属薄膜(14)をエッチング により除去するステップと、

上記酸化領域(16)を上記基板(12)に熱拡散させるステッ プとからなる光導波路の製造方法。

【請求項2】 上記基板(12)はLiNbO3 からなり、 上記金属薄膜(14)はTiからなることを特徴とする請求 項1に記載の光導波路の製造方法。

【請求項3】 上記金属薄膜(14)はレーザビームの照射 により部分的に加熱されることを特徴とする請求項1に 記載の光導波路の製造方法。

【請求項4】 上記酸化領域(16)はその横断面において 一様な金属酸化物からなることを特徴とする請求項1に 記載の光導波路の製造方法。

【請求項5】 上記酸化領域(16)はその横断面において 金属酸化物(16A) と該金属酸化物により囲まれる未酸化 20 部(16B) とからなることを特徴とする請求項1に記載の 光導波路の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、LiNbO3(ニオブ 酸リチウム)等の強誘電体からなる基板にTi(チタ ン)等の金属及び/又はその酸化物を熱拡散させる光導 波路の製造方法に関する。

【0002】光方向性結合器等の光デバイスの一形態と して、光導波路型のものがある。光導波路は、構造上小 30 型化が容易でプレーナ技術等を用いて量産することがで きるという利点を有しており、その製造方法の最適化が 模索されている。

{00031

【従来の技術】図3により、LiNbO₃ からなる基板 にTiを熱拡散してなる光導波路の従来の製造方法の一 例を説明する。

【0004】まず、(A)に示されるように、LiNb O3 からなる基板 2上にTiからなる金属薄膜 4 を形成 する。次いで、金属薄膜4上にレジスト剤を塗布して、 マスクを用いた露光を行うことによって、(B) に示さ れるように、金属薄膜4上にレジストパターン6を形成 する。

【0005】続いて(C)に示されるように、金属薄膜 4のレジストパターン6に対応する部分(4A)を除い て金属薄膜4をエッチングにより除去する。そして、レ ジストパターン6を除去することによって、(D) に示 すように、基板2上に所定形状の金属パターン4 Aが残 る。

2 拡散させることで、基板2に高屈折率部(光導波路のコ ア部)8が形成される。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】図3により説明した従 来方法において、(B)のマスクを用いたレジストの露 光方法としては、マスクを基板にほぼ接触させるコンタ クト露光と、マスクを基板から適当な距離だけ離して露 光を行う投影露光とがある。

【0008】コンタクト露光による場合、マスクが基板 10 に接触するため、パターン不良が発生することが多いと いう問題がある。一方、投影露光による場合、投影露光 用の装置が極めて高価であり製造コストが上昇するとい う問題がある。

【0009】よって、本発明の目的は、レジスト及びマ スクを使用することなしに熱拡散用のパターンを作製す ることができる光導波路の製造方法を提供することにあ る。

[0010]

【課題を解決するための手段】本発明によると、強誘電 体からなる基板上に金属薄膜を形成するステップと、該 金属薄膜を部分的に加熱して酸化領域を生成するステッ プと、該酸化領域を除いて上記金属薄膜をエッチングに より除去するステップと、上記酸化領域を上記基板に熱 拡散させるステップとからなる光導波路の製造方法が提 供される。

[0011]

【作用】本発明の光導波路の製造方法においては、強誘 電体からなる基板上に形成された金属薄膜を部分的に加 熱して酸化領域を生成し、この酸化領域を熱拡散用のパ ターンとして使用するようにしているので、従来のよう なレジスト及びマスクの使用が不要になる。

【0012】金属薄膜を部分的に酸化させると、適当な エッチング液を用いることによって、金属薄膜の未酸化 部のみを除去することができる。

[0013]

【実施例】以下本発明の実施例を説明する。図1は本発 明の第1実施例を示す光導波路の製造プロセスの説明図 である。まず、(A)に示されるように、LiNbO3 からなる基板12上に一様にTiからなる金属薄膜14 を例えば蒸着により形成する。

【0014】次いで、(B) に示されるように、YAG レーザ装置或いはCO₂ レーザ装置等のレーザ装置を用 いて、金属薄膜14の予め定められた部分にレーザビー ムを照射して、その部分を加熱して酸化領域16を生成 する。

【0015】レーザビームの照射により酸化領域を生成 しているのは、レーザビームの照射部分を瞬時に高温に して、正確な形状の酸化領域を得るためである。続い て、金属薄膜14及び酸化領域16が形成された基板を 【0006】最後にこの金属パターン4Aを基板2に熱 50 Ti用のエッチング液に浸漬する。こうすると、金属薄

膜14の未酸化部はエッチングにより除去されるが、酸化領域16はエッチングレートが小さいためにほとんどエッチングされずにそのまま残ってパターンとなる。

【0016】エッチング液としては、例えば過酸化水素水とアンモニアの混合溶液を用いることができる。そして、酸化領域16が残った基板を例えば1000℃以上の温度で加熱するとにより、酸化領域16を基板12内に熱拡散させ、(D)に示されるように、基板12に高屈折率部18を形成する。

【0017】このように、本実施例によると、レジスト 10 及びマスクを使用することなしに、光導波路を形成することができる。酸化領域16はTiOz 或いはTiOz (0<x<2)からなる。従来方法では、所定形状のTiからなるパターンを基板に熱拡散させているが、実際には熱拡散させる際の加熱によりTiパターンが酸化するので、金属酸化物からなるパターンを用いても同様に光導波路を形成することができる。

【0018】図1の第1実施例においては、酸化領域16は、その横断面において一様な金属酸化物からなるが、エッチングに際して酸化領域16が残留すればよい20ので、酸化領域16は一様な金属酸化物であることに限定されない。例えば、酸化領域16の外周部のみが金属酸化物からなりその内部は未酸化でもよいのである。この実施例を次に説明する。

【0019】図2は本発明の第2実施例を示す光導波路の製造プロセスの説明図である。(A)では第1実施例おけるのと同じように $LiNbO_3$ からなる基板12上にTiからなる金属薄膜14を形成する。

【0020】この実施例では、(B)で生成される酸化 領域16は、その横断面において金属酸化物16Aとこ 30 の金属酸化物16Aにより囲まれる未酸化部16Bとか らなる。

【0021】このような酸化領域16を生成するためには、金属酸化物16Aの両側部を生成するときにレーザビームの強度を強くし両側部間の上面部を生成するとき

にレーザビームの強度を弱くすればよい。また、金属酸化物16Aの両側部を生成するときにレーザビームのスポットサイズを小さくし、両側部間の上面部を生成するときにスポットサイズを大きくしてもよい。さらに、金属酸化物の両側部を生成するときにレーザビームの照射時間を長くし、両側部間の上面部を生成するときにレー

4

【0022】このような酸化領域16及び金属薄膜14 が形成された基板12について第1実施例におけるのと 同じようにエッチングを施すと、(C)に示されるよう に、酸化領域16が基板12上に残留するので、これを 基板12内に熱拡散させることによって、(D)に示さ れるように高屈折率部18を得ることができる。

ザビームの照射時間を短くするようにしてもよい。

【0023】本実施例によると、熱拡散に際してのパターンを歩留りよく良好に形成するとができるので、特性ばらつきの少ない光導波路を容易に得ることができる。また、エッチング工程においてもレジストを使わないので、オーバーエッチングが生じにくくなり、エッチング終点の特定等を容易に行うことができる。

20 [0024]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によると、 レジスト及びマスクを使用せずに熱拡散用のパターンを 容易に作製することができる光導波路の製造方法の提供 が可能になるという効果が生じる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1実施例を示す光導波路の製造プロセスの説明図である。

【図2】本発明の第2実施例を示す光導波路の製造プロセスの説明図である。

30 【図3】従来技術の説明図である。

【符号の説明】

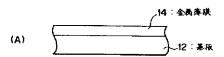
- 12 基板
- 14 金属薄膜
- 16 酸化領域
- 18 高屈折率部

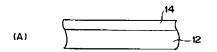
【図1】

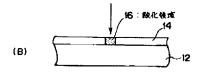
第1 卖施例图

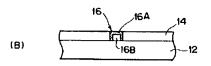
【図2】

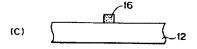
第2実施例園

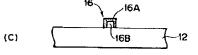


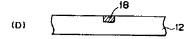


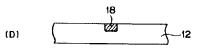












【図3】

從来例図

